МГТУ им. Н.Э. Баумана

Дисциплина электроника

Лабораторный практикум №6

Работу выполнил:

студент группы ИУ7-34Б

Ильченко Ева

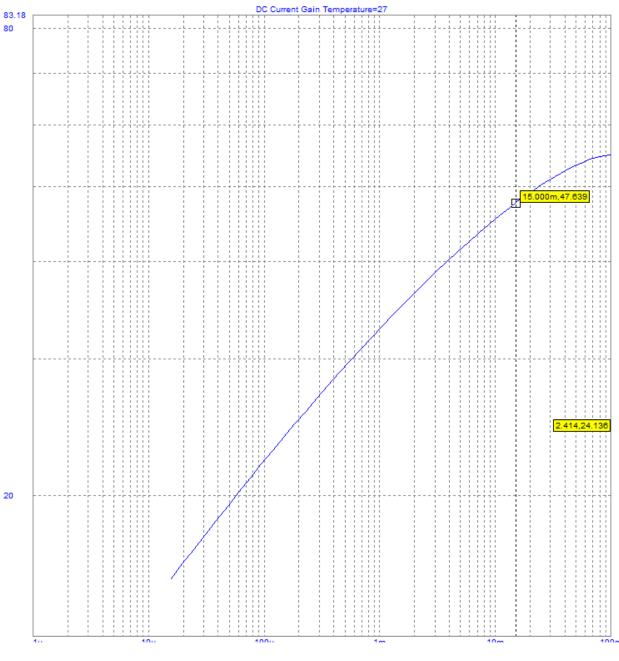
Работу проверил:

ЭКСПЕРИМЕНТ 4.

Ключ на биполярном транзисторе

Рассчитываю сопротивление базы и строю схему:

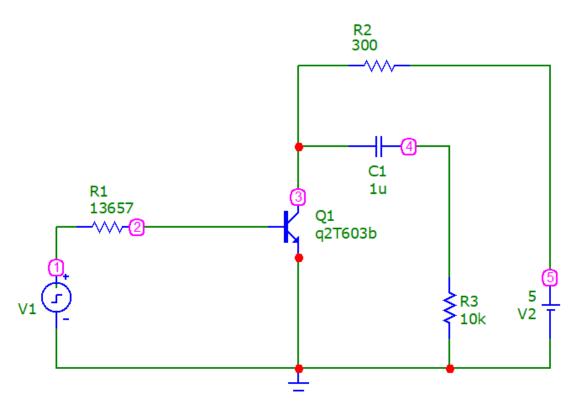
$$I_{ ext{\tiny KHAC}} = rac{E_{ ext{\tiny K}} - U_{ ext{\tiny K9}}}{R_{ ext{\tiny K}}} = rac{4.5}{300} = 15 \; ext{mA}$$

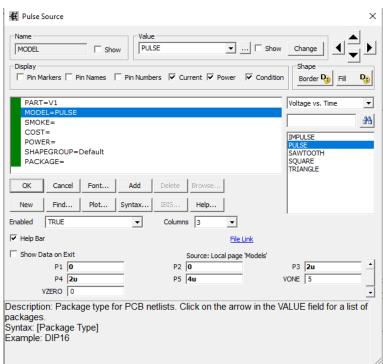


$$I_{\text{6Hac}} = \frac{I_{\text{KHaC}}}{\beta} = \frac{15 * 10^{-3}}{47.639} = 3.15 * 10^{-4} \text{A}$$

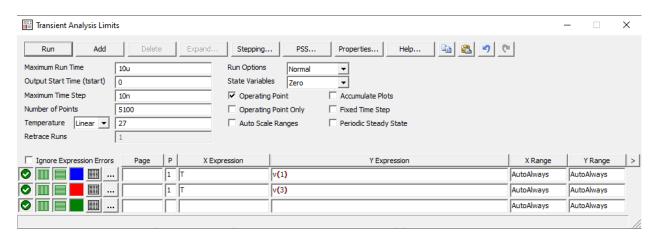
$$R_6(S) = \frac{U_{\text{BX}} - U_{69}}{S * I_{6 \text{ HaC}}} = \frac{4.3}{S * 3.15 * 10^{-4}} = \frac{13657}{S} \text{ Om}$$

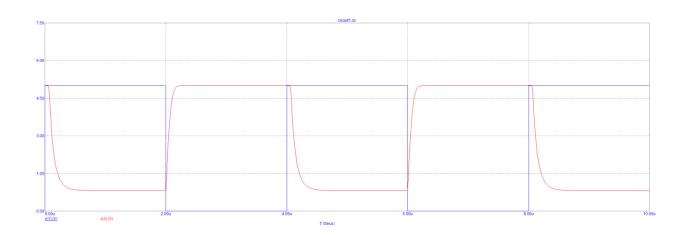
$$R_6(S = 1) = 13657 \text{ Om}$$





Строю график:



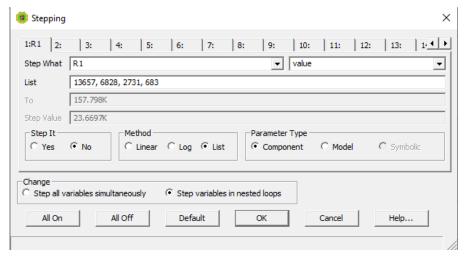


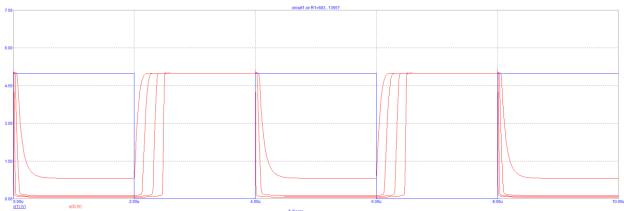
Делаю Stepping:

$$R_6(S=2) = 6828 \text{ Om}$$

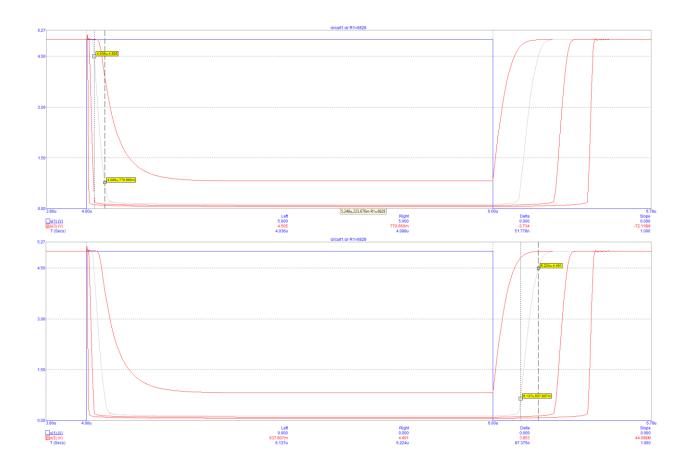
$$R_6(S = 5) = 2731 \text{ Om}$$

$$R_6(S = 20) = 683 \text{ Om}$$



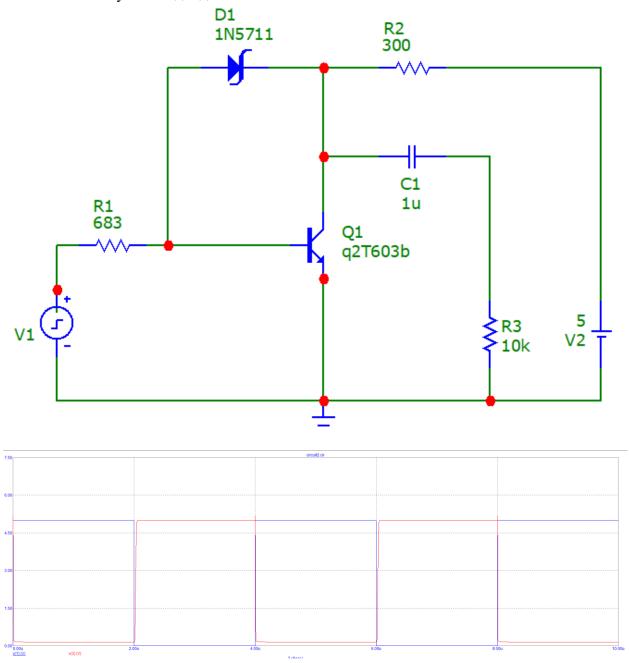


Определяю длительность фронтов, время рассасывания и напряжение на коллекторе в режиме насыщения



S	t10, нс	t01, нс	tp, нс	Uĸ, B
2	52	87	127	0.127
5	21	58	302	0.09
20	6	24	462	0.06

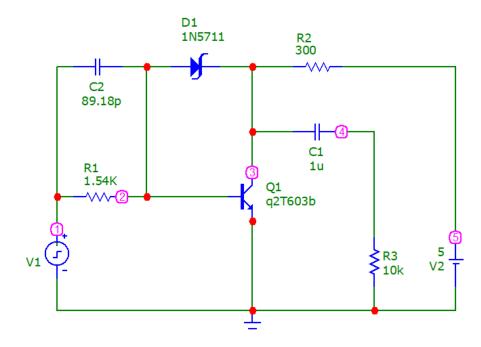
Включаю в схему S = 20 диод Шоттки:



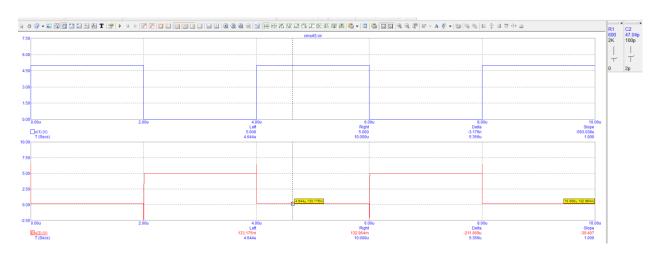
На графике можно увидеть значительно снижение времени рассасывания.

ЭКСПЕРИМЕНТ 5. Повышение быстродействия ключа на биполярном транзисторе

Добавляю в схему форсирующую емкость



При помощи слайдеров подбираю такие C2 и R1, чтобы получить инвертор близкий к идеальному

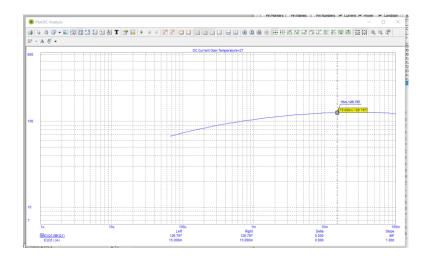


 $C2 = 47.04 \text{ } \pi\Phi$

R1 = 600 Om

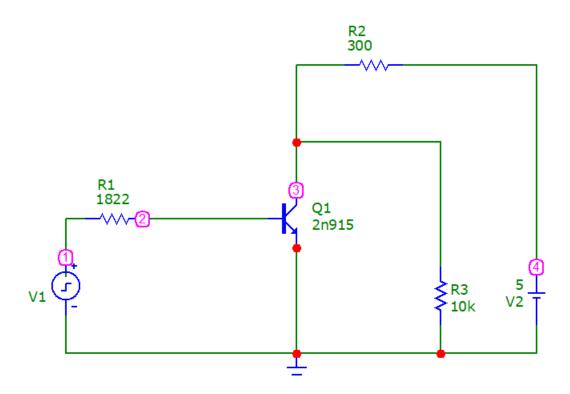
Убираю конденсаторы и диоды, заменяю транзистор на 2N915:

$$I_{ ext{\tiny KHAC}} = rac{E_{ ext{\tiny K}} - U_{ ext{\tiny K9}}}{R_{ ext{\tiny K}}} = rac{4.5}{300} = 15 \; ext{mA}$$



$$I_{\text{6Hac}} = \frac{I_{\text{KHac}}}{\beta} = \frac{15 * 10^{-3}}{126.797} = 1.18 * 10^{-4} \text{A}$$

$$R_6(S) = \frac{U_{\text{вх}} - U_{69}}{S * I_{6 \text{ нас}}} = \frac{4.3}{S * 5.45 * 10^{-5}} = \frac{36441}{S} \text{ Ом}$$



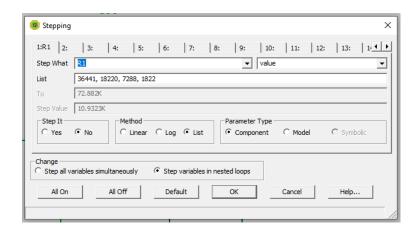
И сразу делаю stepping

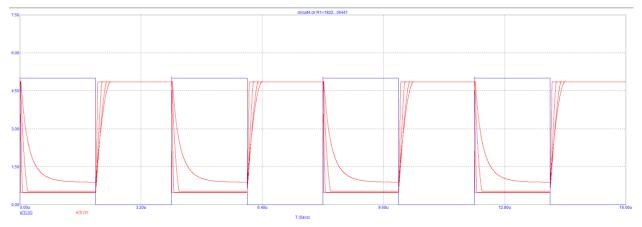
$$R_6(S = 1) = 36441 \text{ Om}$$

$$R_6(S = 2) = 18220 \text{ Om}$$

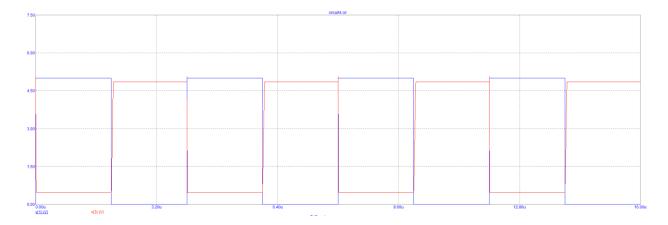
$$R_6(S=5) = 7288 \text{ Om}$$

$$R_6(S = 20) = 1822 \text{ Om}$$





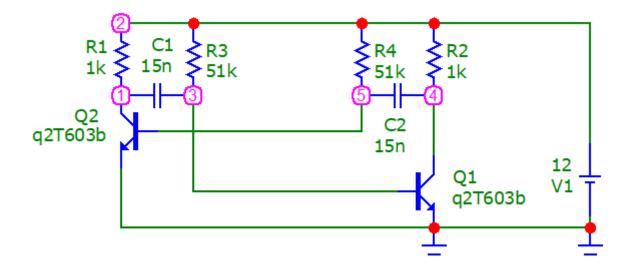
Γ рафик для S=20



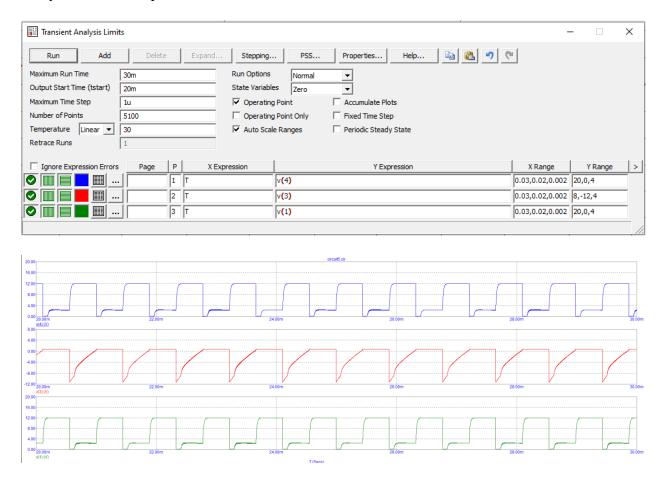
Можно сделать вывод, что для инвертора важен выбор транзистора

ЭКСПЕРИМЕНТ 6. Изучение влияния обратных связей в ключевой схеме на биполярном транзисторе. Период следования коллекторных импульсов:

Строю схему мультивибратора:

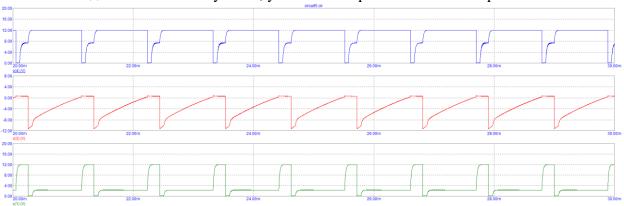


Получаю осциллограммы:

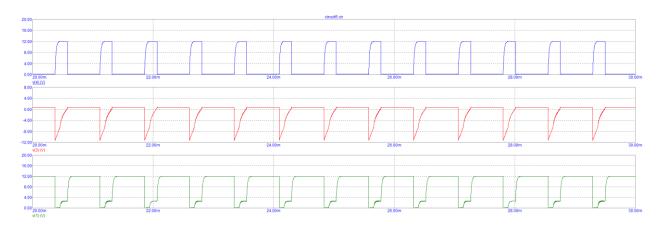


Период следования коллекторных импульсов: 1.082мс

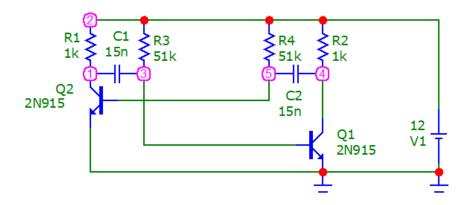
Увеличиваю длительность импульсов, увеличив сопротивление R3 в 2 раза

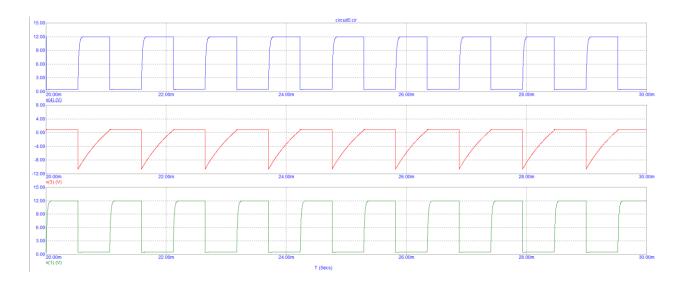


Уменьшаю длительность импульсов, уменьшив сопротивление R3 в 2 раза



Заменяю транзистор в схеме на 2N915:





Можно заметить, что длина импульсов изменилась. Поэтому

делаем вывод, что замена транзистора влияет на длительность колебания.

состояния: Uк \sim = 12 B; время в открытом состоянии \sim = 462 мкс, в закрытом \sim = 509 мкс.

Контрольные вопросы к эксперименту 6

1. Какие элементы имеют основное влияние на частоту мультивибратора?

Транзисторы, цепочки ёмкостей и сопротивлений базы (на схеме рис. 30 – цепочки R3C1 и R4C2)

2. Как влияет замена транзистора на параметры колебания?

Меняется длительность импульса и напряжение на коллекторе в открытом состоянии.

3. Чем отличается работа математической модели мультивибратора от реального устройства?

Математическая модель мультивибратора, в отличие от реального устройства, нуждается во нарушении баланса в плечах, только тогда будет возможно получить колебания.